

第 1 日目 (12月7日)

オ - ラルセッション 1

9 : 35 ~ 10 : 35 座長 寺地徳之 (物材機構)
101 円筒共振型マイクロ波プラズマによるナノ結晶
ダイヤモンドの低温成長

(電通大, サンヨー電子*) 一色秀夫, 飛田龍太郎,
嶺井浩大, 瀧川修平, 田村貴司, 土岐和之*

102 ヘテロエピタキシャルダイヤモンドの選択成長
法を用いたナノスケールドットアレイ形成におけるダ
イヤモンド核密度の影響

(青学大, トウライエンジニアリング*, 阪大**) 菊地啓翔,
児玉英之, 鈴木一博*, 水落憲和**, 澤邊厚仁

103 インチサイズの単結晶ダイヤモンド接合ウ
ェハの作製と大面積化に向けての取組み

(産総研) 山田英明, 茶谷原昭義, 空野由明, 坪内
信輝, 鹿田真一

10 : 35 ~ 10 : 45 休憩

オ - ラルセッション 2

10 : 45 ~ 12 : 05 座長 嘉数誠 (NTT・物性研)
104 ダイヤモンドにおけるバンドギャップ温度依存
性の第一原理計算

(東工大) 是常 隆, 斎藤 晋

105 ダイヤモンド p-i-n 接合ダイオードからの電子
放出(III)

(産総研) 竹内大輔, 牧野俊晴, 加藤宙光, 大串
秀世, 山崎 聡

106 窒素ラジカルビームを用いたダイヤモンド
表面の窒素終端化

(早大) 宇都宮大起, 鹿又龍介, 佐藤隼介,
栗原慎一郎, 小林拓磨, 坪井秀俊, 平岩 篤,
川原田 洋

107 イオンゲルを用いたダイヤモンド FET の電
気容量測定

(早大) 横山悠樹, 田辺恭介, 新井裕史, 小野
拓, 井堀翔志, ルスリグ アブドル 元ム, 平岩 篤,
川原田 洋

12 : 05 ~ 13 : 00 昼 休 み

オ - ラル特別セッション「パワーデバイス」

13 : 00 ~ 14 : 30 座長 野瀬 健二(東大・生産
技研)

108 【基調講演】ワイドギャップ半導体パワーデバ
イスへの期待と展開

(産総研) 梅澤 仁

109 ダイヤモンド・ナノマシンスイッチの創製
(物材機構) 廖 梅勇, 菱田俊一, 小泉 聡,
小出康夫

110 AlN/Diamond ヘテロ接合型ダイヤモンド電
界効果トランジスタの開発

(物材機構) 井村将隆, 早川竜馬, 大里啓孝,
渡辺英一郎, 津谷大樹, 廖 梅勇, 小出康夫, 天野
浩

111 単結晶ダイヤモンドにエピタキシャル成長
した AlGaIn/GaN HEMT の高周波高出力動作

(NTT・物性研) 平間一行, 谷保芳孝, 嘉数 誠

14 : 30 ~ 14 : 40 休憩

オ - ラルセッション 3

14 : 40 ~ 16 : 20 座長 梅澤 仁 (産総研)
112 高濃度 NO₂ 吸着による水素終端ダイヤモンドの
正孔濃度の増加と FET 特性の改善

(NTT・物性研) 嘉数 誠, 佐藤寿志, 平間一行

113 金属/ダイヤモンド界面の不完全性とショット
キーダイオード特性

(物材機構, CNRS*, 九州大**) 寺地徳之, A.Fiori
*, 大曲新矢**, 小出康夫

114 ダイヤモンド半導体を用いたバイポーラトラン
ジスタの開発

(産総研) 山崎 聡, 加藤宙光, 牧野俊晴, 竹内大
輔, 小倉政彦

115 高濃度不純物をドーブしたダイヤモンド薄膜に
おける電荷輸送機構

(筑波大, 産総研*) 松本 翼, 小倉政彦*, 加藤宙
光*, 大串秀世*, 山崎 聡*

116 ダイヤモンド pn 接合陰極の動作条件と安定性
(物材機構) 小泉 聡

ポスタ - セッション

16 : 20 ~ 18 : 20

P1-01 ダイヤモンド半導体電気測定のための電極
構造の検討

(神奈川大) 本杉太郎, 中田穰治, 星野 靖, 斎藤保
直

P1-02 ダイヤモンドオーミック電極とショットキ
ー電極の電位の光電子分光的検証

(青学大, トウライエンジニアリング*) 小黒一希, 河野省
三, 鈴木琢也, 知野大仁, 鈴木一博*, 児玉英之, 澤
邊厚仁

P1-03 テンプレート層高品質化によるポロンドー
ブヘテロエピタキシャルダイヤモンドの電気特性の向
上

(青学大, トウライエンジニアリング*) 知野大仁, 児玉英
之, 鈴木一博*, 澤邊厚仁

P1-04 ダイヤモンド中の電子・正孔対の捕獲・再
結合過程

(産総研) 牧野俊晴, 菅野正吉, 大串秀世, 加藤宙
光, 竹内大輔, 山崎 聡

P1-05 同位体ダイヤモンド超格子からのラマン散
乱

(産総研, 徳島大*) 渡邊幸志, 富田卓朗*, 中島信
一, 加藤有香子, 鹿田真一

P1-06 種々ダイヤモンド膜厚を持つダイヤモンド
紫外線センサーの光応答特性

(物材機構) 廖 梅勇, M.Allouche, 寺地徳之, 井
村将隆, 小出康夫

P1-07 単結晶ダイヤモンドを用いた高周波 S A W
共振子

(千葉大, MES*, 産総研**) 山田晴也, 小田原達矢,
大森達也, 橋本研也, 藤井 知, 鳥居博典*, 梅澤
仁**, 鹿田真一**

P1-08 単結晶(100)ダイヤモンドにおけるコンダク

- タンス法を用いた界面準位評価
(早大) 大長 央, 佐藤隼介, 小林拓磨, 今橋大樹, 平岩 篤, 川原田 洋
- P1-09 ボロンドルタドーブチャネルを用いたダイヤモンド電解質溶液ゲートFETの開発
(早大) 成尾智也, 小野 拓, 田辺恭介, 井堀翔志, 新井裕史, 川原田 洋
- P1-10 p型アルミニウムドーブダイヤモンドの成長及び特性評価
(早大) 坪井秀俊, 栗原慎一郎, 野村 亮, 鹿又龍介, 宇都宮大起, 平岩 篤, 川原田 洋
- P1-11 マイクロ波プラズマCVDによるBドーブダイヤモンドの作製に及ぼすキャリアガスの影響
(千葉工大) 下村 光, 坂本幸弘
- P1-12 マイクロ波プラズマCVDを用いたダイヤモンド選択成長
(産総研) 永瀬成範, 梅澤 仁, 鹿田真一
- P1-13 CIP-CSLR法と多重格子法の併用によるダイヤモンド成長時基板温度分布の精密解析
(青学大) 森竹利行, 児玉英之, 河野省三, 澤邊厚仁
- P1-14 大型自立単結晶CVDダイヤモンド板の作製とその結晶性及び放射線応答
(産総研, 北大*) 坪内信輝, 空野由明, 垣本明憲*, 藤田文行*, 金子純一*, 山田英明, 茶谷原昭義, 鹿田真一
- P1-15 側面成長を利用した単結晶CVDダイヤモンド自立板の高品質化
(産総研) 空野由明, 茶谷原昭義, 山田英明, 坪内信輝
- P1-16 多段成長を用いたSi基板上での単結晶ダイヤモンド作製
(電通大) 田村貴司, 一色秀夫, 松島賢史郎
- P1-17 イオンビーム処理 -Al₂O₃(11-20)へのダイヤモンド(001)/イリジウム(001)エピタキシャル成長
(青学大, トウラスエンジニアリング*, 並木精密**) 館厚樹, 児玉英之, 鈴木一博*, 古滝敏郎, 澤邊厚仁
- P1-18 MMSi添加によるGaN上ダイヤモンド核発生と薄膜堆積
(電通大) 松島賢史郎, 一色秀夫, 田村貴司
- P1-19 窒化炭素へのダイヤモンド合成
(千葉工大) 坂本幸弘, 田中一平
- P1-20 表面スルホ化多孔質ダイヤモンド球状粒子の作製と固体酸触媒への応用
(東京理科大) 森村卓司, 小林茉莉, 近藤剛史, 湯浅 真
- P1-21 ダイヤモンドマイクロ電極を用いたドーパミン検出
(慶應大, 順大*) 加藤太亮, 吉見建二*, 神園知亜, 渡辺剛志, 北澤 茂*, 栄長泰明
- P1-22 アモルファス水素化炭素膜表面への-グルプリン吸着形態の評価
(長岡技科大) 竹田 葵, 大塩茂夫, 赤坂大樹, 斎藤秀俊
- P1-23 酵素/コバルトフタロシアニン修飾ダイヤモンド印刷電極の作製と高感度グルコースセンサーへの応用
(東京理科大) 堀谷 勝, 坂本博紀, 近藤剛史, 湯浅 真
- P1-24 金属錯体ポルフィリン修飾ダイヤモンド電極によるO₂・の電気化学的検出
(東京理科大) 制野博太郎, 近藤剛史, 湯浅 真
- P1-25 炭素系薄膜の抗菌性評価
(東京電機大, キョウウツ大*, ホーニョ大**, 物材機構***, 三共S/S****) 岩月正人, 大越康晴, アリ・アラジジ-*, 佐藤慶介**, 深田直樹***, 増子貞光****, 平栗健二, 福井康裕
- P1-26 生体材料へ形成した窒素添加a-C:H膜の生体適合性評価
(東京電機大, キョウウツ大*) 世良穂高, 大越康晴, アリ・アラジジ-*, 平栗健二, 福井康裕
- P1-27 フッ素添加ダイヤモンドライクカーボン上における血管内皮細胞の適合性評価
(慶應大, 東邦大・医療センター/慶應大*) 北川智也, 長谷部光泉*, 吉本幸洋, 永島 壮, 藪野 元, 堀越 拓, 鈴木哲也
- P1-28 微量センシングを指向したスクリーン印刷ダイヤモンド電極の作製
(東京理科大) 坂本博紀, 近藤剛史, 四反田 功, 坂垣昌幸, 湯浅 真
- P1-29 導電性ダイヤモンドペーパーの作製と評価
(東京理科大) 谷島啓太, 児玉泰孝, 近藤剛史, 湯浅 真
- P1-30 ダイヤモンドナノ粒子の表面制御と電気化学特性評価
(東京理科大) 浦井純一, 近藤剛史, 湯浅 真
- P1-31 多孔質ダイヤモンド球状粒子のカラム充填材への応用
(東京理科大, 資生堂医理化学科*) 小林茉莉, 近藤剛史, 門田靖彦, 湯浅 真
- P1-32 導電性ダイヤモンドパウダーの燃料電池触媒担体への応用
(東京理科大) 増田秀剛, 池尻貴宏, 近藤剛史, 湯浅 真
- P1-33 熱処理による多孔質導電性ダイヤモンドの作製と電気化学的評価
(東京理科大) 児玉泰孝, 近藤剛史, 湯浅 真
- P1-34 ダイヤモンド電極による有機物の高電位電解検出
(東京理科大, 慶應大*) 田村勇介, 近藤剛史, 渡辺剛*, 栄長泰明*, 湯浅 真
- P1-35 マイクロ流路を有するダイヤモンド電極の試作と特性評価
(東工大) 浅野禎介, 大竹尚登
- P1-36 BDD電極を用いたCO₂の電解還元におけるホウ素ドーブ量の影響
(慶應大, KAST*, 東京理科大**) 尾崎拓也, 中田一弥*, 落合 剛*, 村上武利*, 藤嶋 昭**, 栄長泰明
- P1-37 表面修飾ダイヤモンド電極を用いたCO₂の電気化学的還元
(慶應大, KAST*, 東京理科大**) 安達大雅, 中田一弥*, 落合 剛*, 村上武利*, 藤嶋 昭**, 栄長泰明
- P1-38 ウェット酸化によるダイヤモンド(111)表面の酸素終端
(金沢大, 産総研*) 神谷昇吾, 福井 真, 徳田規夫, 牧野俊晴*, 竹内大輔*, 山崎 聡*, 猪熊孝夫

第 2 日目 (1 2 月 8 日)

オ - ラルセッション 4

9 : 0 0 ~ 1 0 : 4 0 座長 平田 敦 (東工大)

201 光化学修飾法による酸素終端 DLC 膜の作製
および表面化学構造制御

(産総研) 中村 拳子 , 大花 継頼

202 細胞挙動に及ぼす炭素系被膜の影響に関する
検討

(東京電機大) 大越 康晴 , 和田 知明 , 野中 一洋 ,
平栗 健二 , 舟久 保昭夫 , 福井 康裕

203 DLC 膜の耐荷重特性

(ジェイテクト) 鈴木 雅裕 , 齊藤 利幸 , 山川 和芳

204 Si および N 同時添加 DLC 膜の機械的特性お
よびトライボロジー特性

(弘前大) 中澤 日出樹 , 奥野 さおり , 三浦 創史 ,
鎌田 亮輔

205 ナノインデンテーション法を用いたアルミ
合金上 DLC 薄膜の破壊試験

(東大・生産技研) 野瀬 健二 , 佐々木 勇斗 , 神子 公
男 , 光田 好孝

1 0 : 4 0 ~ 1 0 : 5 0 休憩

オ - ラルセッション 5

1 0 : 5 0 ~ 1 1 : 3 0 座長 竹内 大輔 (産総
研)

206 ダイヤモンド半導体を用いた量子情報素子
(阪大 , 産総研* , シュトゥットガルト大** , ブタースト大*** ,
カム大****) 水落 憲和 , 土井 悠生 , 森 周太 , 牧野
俊晴* , 加藤 宙光* , 小倉 政彦* , 竹内 大輔* , 大串 秀世
* , M. Nothaft** , P. Neumann** , A. Gali*** ,
F. Jelezko**** , J. Wrachtrup** , 山崎 聡*

207 双極子双極子相互作用を制御した NV センタ
ーの作成エンジニアリング

(日本原研 , 物材機構* , 筑波大** , 住友電工***)

小野田 忍 , 山本 卓 , 阿部 浩之 , 花屋 博明 , 大島
武 , 谷口 尚* , 寺地 徳之* , 渡邊 賢司* , 小泉 聡* ,
神田 久生* , 磯谷 順一** , 梅田 享英** , 角谷 均***

1 1 : 3 0 ~ 1 2 : 2 0 昼 休 み

ポスタ - セッション

1 2 : 2 0 ~ 1 4 : 2 0

P2-01 原子的平坦ダイヤモンド(111)表面のグラフ
ァイト化によるグラフェン・オン・ダイヤモンド形成
(金沢大 , MST* , 産総研**) 福井 真 , 徳田 規夫 ,
小島 健太郎* , 小松 佳奈子* , 船津 国博* , 牧野 俊晴** ,
竹内 大輔** , 山崎 聡** , 猪熊 孝夫

P2-02 フラーレン薄膜を利用した導電性薄膜の形
成

(東海大) 古川 雄一 , 新井 龍一 , 葛巻 徹

P2-03 垂直配向 CNTs におけるコンタクトモード
AFM を用いた接触抵抗の評価

(早大) 稲葉 優文 , 大原 一慶 , 落合 拓海 , 平岩 篤 ,
川原 田 洋

P2-04 原子間力顕微鏡を用いたカーボンナノチュ
ーブの機械的性質の評価

(東海大) 宮内 創 , 葛巻 徹 , 川原 靖孝 , 太田 堯
之 , 秋田 悠太 , 竹内 健人

P2-05 CNT 紡績糸形成時の荷重計測

(東海大) 秋田 悠太 , 竹内 健人 , 葛巻 徹

P2-06 カーボンナノチューブ薄膜を負極とする全
固体型リチウムイオン電池の作製

(東海大) 川原 靖孝 , 葛巻 徹 , 太田 堯之 , 和地 隼
人

P2-07 SWCNTs をキャリアとしたがん細胞イメージ
ングプローブの開発

(筑波大 , 産総研*) 飯泉 陽子 , 岡崎 俊也* , 田原 善夫
* , 湯田 坂雅子* , 飯島 澄男*

P2-08 X 線トポグラフィによる IIa 型 HPHT ダイヤ
モンド単結晶の転位解析

(産総研) 加藤 有香子 , 梅澤 仁 , 山口 隆博 , 鹿田
真一

P2-09 酸素終端ダイヤモンド表面の結合開裂反応
と熱的特性評価

(山形工技センター) 佐竹 康史 , 鈴木 庸久 , 加藤 睦人 ,
齊藤 寛史

P2-10 各種ガスを用いたプラズマ CVD 法による高
分子材料への DLC コーティングとその物性評価

(茨城大 , 東京電機大*) 宮澤 真吾 , 尾関 和秀 , 平
栗 健二* , 増澤 徹

P2-11 円筒状構造物内壁面への炭素系薄膜形成

(東京電機大 , キョウカド大* , ホロニヤ大** , 物材機構*
**) 武田 直幸 , 大越 康晴 , アリ. アルアジニ* , 佐藤 慶介*
* , 深田 直樹*** , 平栗 健二 , 福井 康裕

P2-12 Deposition of Mg-doped amorphous carbon
films by co-cvaporation of C60 fullcrene and
magnesium in Electron Beam Excited Plasma

(東工大) Hamed V Taghavi , 平田 敦

P2-13 磁場援用プラズマ CVD による炭素膜の合
成

(日本工大) 岸部 一機 , 渡部 修一

P2-14 各種原料ガスで成膜した DLC 膜の水素量と
シミュレーションによる検討

(茨城大 , 長岡技科大* , 東京電機大**) 尾関 和秀 ,
佐藤 元気 , 鈴木 常生* , 平栗 健二** , 増澤 徹

P2-15 水素化アモルファス炭素膜の重水素化添加
による効果

(長岡技科大) 赤坂 大樹 , 鈴木 常生 , 大塩 茂夫 , 斎
藤 秀俊

P2-16 ナノ材料試験システムによる DLC 薄膜の引
張強度評価

(東海大 , 東工大*) 石山 義行 , 小原 佑記 , 佐藤 亮
太 , 葛巻 徹 , 高島 舞* , 大竹 尚登*

P2-17 Ti 中間層を設けた研磨ダイヤモンド膜とス
テンレス鋼材間の摩擦特性

(東北大) 中山 遥佑 , 三木 寛之 , 竹野 貴法 , 高木 敏
行

P2-18 ダイヤモンドおよび DLC 膜の疲労特性評価
(日工大) 町田 成康 , 齊藤 圭右 , 廣田 亮 , 竹内 貞
雄

P2-19 生物電子顕微鏡のための DLC 膜の機械的
特性評価

(広島県総合技研・西部工技センター , 広島国際大*)
縄 雅典生 , 伊藤 幸一 , 山本 晃 , 上月 具孝

P2-20 DLC コーティングおよび表面処理を施したポ
リプロピレン材料のガスバリア性向上

(慶應大) 田代 裕樹 , 堀田 篤

P2-21 DLC コーティングによるマグネシウム合

金の耐食性の向上

(産総研) 池山雅美, 園田 勉

P2-22 色差によるダイヤモンド状炭素膜の評価
(長岡技科大, 堀場 S/S*, 兵庫県大**) 水口和也,
桜井正行*, 神田一浩**, 赤坂大樹, 大塩茂夫, 斎藤
秀俊

P2-23 金属含有アモルファスカーボン薄膜の合成
と電気的特性評価

(東工大) 奥山紘章, 大竹尚登

P2-24 RF プラズマ CVD で合成したボロンドープ
DLC 膜の電気抵抗率の評価

(日工大) 町田成康, 古谷泰一, 竹内貞雄

P2-25 DLC 膜の軟 X 線照射効果
(兵庫県大, 神戸大*) 藤本昌宏, 神田一浩, 横田
久美子*, 田川雅人*

P2-26 DLC コーテッド金型による亜鉛めっき鋼管の
ドライ加工

(日本工大, ヨシホ* ール*, 神港精機**) 古谷泰一,
町田成康, 塩原秀夫*, 佐藤直紀*, 寺山暢之**, 竹内
貞雄

P2-27 ナノクラスタ金属を含む非晶質炭素膜を利用
した歪みセンサ

(東北大) 竹野貴法, 大野 威, 三木寛之, 高木敏
行

P2-28 アクリロニトリル中で堆積した窒化炭素膜
の電気的特性

(東海大) 東 幹晃, 清田英夫, 黒須楯生, 千葉雅
史

P2-29 異なる CH₄ 流量でマイクロ波プラズマ CVD
により合成した窒化炭素のトライボロジー特性

(千葉工大) 田中一平, 坂本幸弘

P2-30 CFRP の放電切削加工の試み

(東工大) 平間俊晴, 安原鋭幸, 大竹尚登

P2-31 炭化タングステン粉末の通電焼結における
カーボンオニオンの潤滑作用

(東工大) 平田 敦, 中川一平

P2-32 気相合成ダイヤモンド単結晶の品質

(イディビ-) 藤森直治

P2-33 同位体濃度を高めた高純度高温高压合成ダ
イヤモンドの特性

(住友電工, 筑波大*) 池田和寛, 角谷 均, 磯谷
順一*

P2-34 ダイヤモンド薄膜の同位体濃縮

(物材機構, 筑波大*, 日本原研**, UIm 大***,
Stuttgart 大****) 寺地徳之, 磯谷順一*, 小野田
忍**, F. Jelezko***, J. Wrachtrup****

P2-35 炭素同位体組成を制御した高純度ダイヤモ
ンド単結晶の高圧合成

(物材機構, 筑波大*) 谷口 尚, 寺地徳之, 磯谷順
一*

P2-36 海水淡水化施設の廃水中から有用資源物の
ダイヤモンド電極による電解回収

(佐賀大) 池田 進, 川内由美, 田尾晋太郎

オ - ラル特別セッション「グラフェン」

14:20 ~ 15:50 座長 葛巻 徹 (東海大)

208 【基調講演】グラフェンの光電子デバイス応
用: 研究動向と将来展望

(東北大) 尾辻泰一

209 マイクロ波プラズマ CVD 法によるグラフェ

ンのロール・トゥ・ロール成膜

(産総研) 山田貴壽, 石原正統, 金 載浩, 長谷川
雅考, 飯島澄男

210 プラズマ CVD によるグラフェンの大面積成
膜と太陽電池への応用

(中部大) 加タゴラップ, 内田秀雄, 脇田紘一, 梅野
正義

211 ヘテロエピタキシャル Ni 薄膜上での単層・
二層グラフェンの制御合成

(東工大/マックスプランク研究所, マックスプランク研究所*, ル
ド大**) 岩崎孝之, Hye Jin Park*, 小沼光春*,
Dong Su Lee*, Alexei Zakharov**, Jurgen H. Smet*,
Ulrich Starke*

15:50 ~ 16:00

休憩

オ - ラルセッション 6

16:00 ~ 17:00 座長 岡崎俊也 (産総研)

212 グラフェン・アンチドット系の半導体特性
(東工大) 斎藤 晋, 櫻井誠大

213 原子間力顕微鏡によるグラフェンの局所陽
極酸化

(東大・生産技研) 増淵 寛, 荒井美穂, 野瀬健二,
光田好孝, 町田友樹

214 グラフェンを用いた高性能リチウムイオン
二次電池負極

(三重大, 産総研*) 小海文夫, 千種 甫, 宗林里
佳, 花井一真, 小塩 明, 石原正統*, 古賀義紀*, 長
谷川雅考*, 今西誠之, 武田保雄

17:00 ~ 17:10

休憩

特別講演

17:10 ~ 18:00 座長 小出康夫 (物材機構)

「ダイヤモンドを材料として使うことを目指して」

(株)イーディービー

代表取締役社長 藤森 直治 氏

懇 親 会 (ホテルグランド東雲) 18:30 ~

第 3 日目 (12月9日)

オ - ラルセッション 7

9:40 ~ 11:20 座長 中村 孝子 (産総研)

301 生体環境下で高い溶解性を示すナノダイヤ
モンドの創製とクロマトグラフィーによるサイズ分離
(滋賀医科大) 小松直樹, Zhao Li, 瀧本竜哉, 木
村隆英

302 インクジェット法にて形成したフラーレン
結晶微粒子による細胞毒性

(日工大) 伴 雅人, 佐々木扶紗子, 古城裕矢

303 単層カーボンナノチューブの安全性試験に
おける電子顕微鏡観察

(産総研, 産業医科大*) 山本和弘, 吉田智子, 後
藤理恵, 大神 明*, 森本泰夫*

304 カーボンオニオンの砥粒性能とその生成原
料との関係

(東工大) 平田 敦, 向後博康

305 カーボンナノチューブをテンプレートとし

たナノ構造体合成

(産総研,筑波大*) 岡崎俊也,丹下将克,飯泉陽子*,劉 嶧,末永和知,岡田 晋*,飯島澄男

11:20~12:20 昼 休 み

オ - ラルセッション 8

12:20~13:40 谷口 尚(物材機構)

306 高周波加熱炉と金属溶媒による hBN 結晶合成と評価

(北大,物材機構*) 佐竹良太,金子純一,坪田陽一,谷口 尚*,藤田文行,樋口幹雄

307 アモルファス窒化炭素薄膜の電気伝導度の窒素含有率依存性

(防衛大) 田村尚之,青野祐美,若菜庸央,岩崎千尋,北沢信章,渡邊芳久

308 アモルファスカーボンナイトライド形成における CN ラジカルの寄与について

(長岡技科大) 伊藤治彦,山本愛弓,斎藤秀俊

309 RF 反応性スパッタリングによる CNx 膜形成時におけるスパッタガスの影響

(千葉工大) 城谷友保,坂本幸弘

13:40~13:50 休憩

オ - ラルセッション 9

13:50~15:30 高岡 秀充(三菱マテリアル)

310 紫外光支援加工による単結晶ダイヤモンド

基板の超精密研磨技術

(熊本大,産総研*) 峠 睦,久保田章亀,長野拓義,横井裕之,鹿田真一*,梅澤 仁*,加藤有香子*,茶谷原昭義*

311 モザイク状 CVD ダイヤモンド単結晶自立板の作製

(住友電工) 植田暁彦,西林良樹,角谷 均

312 選択成長によるヘテロエピタキシャルダイヤモンド放射線検出器の特性向上

(青学大,トウラスインジコリング*) 永井克将,児玉英之,鈴木一博*,河野省三,澤邊 厚仁

313 オフ角制御高圧高温合成 a 基板上への CVD 単結晶ダイヤモンドの合成と評価 2~CH4 濃度による特性変化~

(北大,AIST*,NIFS**) 金子純一,佐竹良太,藤田文行,今野雄太,西 紀彦,後藤拓人,渡邊幸志*,茶谷原昭義*,梅澤 仁*,坪内信輝*,鹿田真一*,磯辺光孝**

314 低欠陥高品質大型単結晶ダイヤモンドの高圧合成と特徴

(住友電工) 角谷 均,原野佳津子

優秀講演賞について

優秀講演賞の選考対象となる発表には講演番号の前に 印が付記されています。